



◆ 2 W

- 薄膜
- 高衰减精度
- 低驻波比
- 陶瓷芯片：99% 氧化铝
- 激光调阻
- 高性价比

A: 金丝键合
B: 无铅回流焊
C: 包三边

注：所有尺寸均用毫米标示

频率范围	DC to 18 GHz
衰减量	2 dB
衰减精度（典型值）	± 0.5 dB DC to 4 GHz + 0.5 dB 4 to 8 GHz + 0.5 dB 8 to 12.4 GHz + 1.0 dB 12.4 to 18 GHz
衰减稳定度	0.0001 dB/dB/°C
阻抗	50 Ohm
额定输入功率	2 W
工作温度	-55 °C to +150 °C

频率范围 (GHz)	VSWR(:)典型值
DC to 4	1.05
4 to 8	1.10
8 to 12.4	1.15
12.4 to 18	1.40

介质基板	99% 氧化铝
电极	金钛钨合金 金厚度 : $3\text{ }\mu\text{m}$
电阻	TaN 薄膜

环境温度 (°C)	额定功率百分比 (%)
-55	100
100	100
150	0